

半導体記憶装置

多値差動ロジックを用いたロジック回路、記憶回路、複合回路

概要

従来のCMOS回路を用いたLSIにおいては、クロック数の上昇に伴い、消費電力の増大が指摘されている。電流モードによる回路技術は、600MHz程度の周波数以上においては、CMOSよりも消費電力の低減が図ることができる。

本発明は、多値作動ロジックに基づくフリップフロップの構成により、静的な記憶保持回路を提供するものである。これまでの研究の結果で、多値差動ロジックを用いて、ロジック回路、記憶回路、複合回路の構成が可能となった。

効果・応用例

●応用例

- 多値差動ロジックを用いたロジック回路、記憶回路、複合回路

特許データシート

特許番号(整理番号):特開2007/023727A1 (T05-100)

発明者:羽生 貴弘

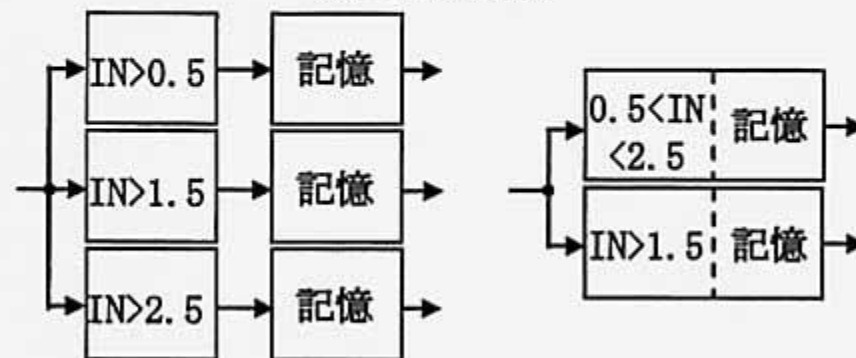
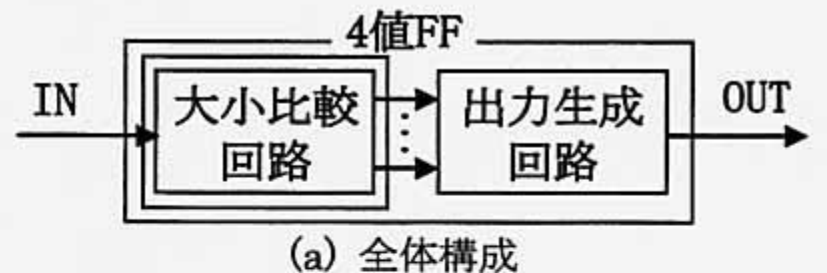


図1: 4値フリップフロップ(FF)の構成

連絡先

株式会社 東北テクノアーチ

TEL 022-222-3049 FAX 022-222-3419

お問い合わせは、[こちら](#) からお願い致します。